

CZ 17953 U1

Příklady provedení

Příklad 1

Zapojení rezonančního elektrického zdroje v první variantě příkladového provedení (viz obr. 1) je rozděleno vzdálenou dvěma rezonančními obvody. První rezonanční obvod, tvorený bifilární cívkou L_1 a kapacitou C_1 , je připojen na zdroj sifákového proudu přes triak T a první diodu D_1 . Před bifilární cívkou L_1 má zapojen zádešový odpor Z_1 . Druhý rezonanční obvod, tvorený bifilární cívkou L_2 a kapacitou C_2 , je připojen na zdroj sifákového proudu přes triak T a druhou diodu D_2 orientovanou propůjčením směrem opačně než první dioda D_1 , a před bifilární cívkou L_2 má zapojen zádešový odpor Z_2 .

Oba rezonanční obvody mají parametry nastaveny na rezonanci v oblasti 50 Hz. PH rezonanci vzniká na diodách D_1 a D_2 velké inverzní napětí, které se přividí zpět do záloh Z_1 a Z_2 .

Příklad 2

Zapojení rezonančního elektrického zdroje ve druhé variantě příkladového provedení (viz obr. 2) je stejný jako v příkladu 1, rozeňen vzdálenou dvěma rezonančními obvody. Také jednotlivé komponenty rezonančních obvodů, posuz bifilárních cívek L_1 a L_2 i princip zapojení záloh Z_1 a Z_2 před bifilární cívek L_1 a L_2 , je shodný s příkladem 1.

NÁROKY NA OCHRANU

1. Rezonanční elektrický zdroj, **vyznačující se tím**, že je rozeňen vzdálenou dvěma rezonančními obvody, při čemž první rezonanční obvod, tvorený bifilární cívekou (L_1) a kapacitou (C_1) , je připojen na zdroj sifákového proudu přes první diodu (D_1) a před bifilární cívekou (L_1) má zapojen zádešový odpor (Z_1) , zatím co druhý rezonanční obvod, tvorený bifilární cívekou (L_2) a kapacitou (C_2) , je připojen na zdroj sifákového proudu přes druhou diodu (D_2) orientovanou propůjčením směrem opačně než první dioda (D_1) a před bifilární cívekou (L_2) má zapojen zádešový odpor (Z_2) .

2. Rezonanční elektrický zdroj podle nároku 1, **vyznačující se tím**, že oba rezonanční obvody mají parametry nastaveny na rezonanci v oblasti 50 Hz.

Výkres

12

CZ 17953 U1

Obr. 1

Obr. 2

Konc dokumentu

- 3 -